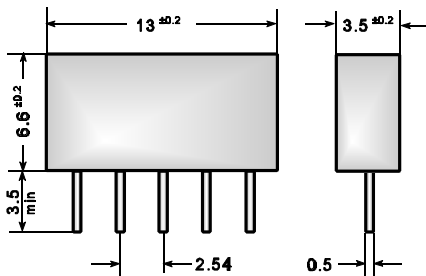
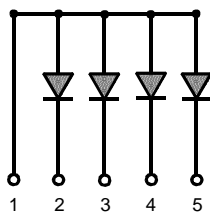


Small Signal Diode Arrays
Dioden Sätze mit Allzweckdioden


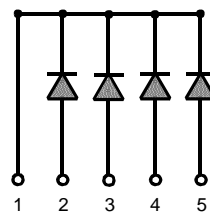
Dimensions / Maße in mm

Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	80 V
5 Pin-Plastic case 5 Pin-Kunststoffgehäuse	13 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. Gewicht ca.	0,6 g

Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton



"DAP": com. anodes / gemeinsame Anode



"DAN": com. kathodes / gemeinsame Kathode

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspg. V_R [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RM} [V]
DAN 401	80	80
DAP 401	80	80

Max. average forward rectified current, R-load, For one diode operation only For all diodes together	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} 100 mA ¹⁾ I_{FAV} 150 mA ¹⁾
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, Für eine einzelne Diode Für alle Dioden zusammen	$T_U = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} 100 mA ¹⁾ I_{FAV} 150 mA ¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 500 mA
 Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+150°C
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+150°C

Characteristics	Kennwerte			
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	V_F	< 1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20 \text{ V}$	I_R	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$		t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 85 K/W ¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden